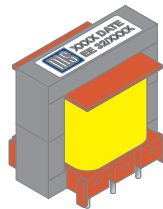
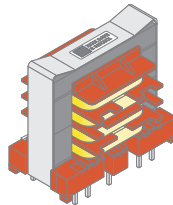


Speicherdrosseln
EE 13 - EE 32



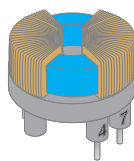
02.01 - 02.05

Funkentstördrosseln
E 30



02.06 - 02.07

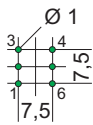
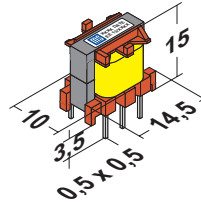
Funkentstördrosseln
R 10



02.08

Speicherdrosseln, stehend

Baureihe EE 13



Ansicht auf Stiftseite
Raster = 3,75 mm



Wicklungsanordnung

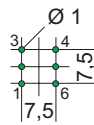
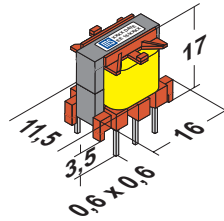
Typ	Vorzugsreihe 1/2L ² ca. 125 μWs			
	Nennstrom [ADC]	Lo [μH]	Ln [μH]	Rcu [mOhm]
EE 13-0,12/ 8500	0,12	10500	8500	12000
EE 13-0,16/ 5200	0,16	6500	5200	7300
EE 13-0,20/ 3300	0,20	4000	3300	4500
EE 13-0,25/ 2500	0,25	3000	2500	3200
EE 13-0,32/ 1600	0,32	2000	1600	2100
EE 13-0,40/ 900	0,40	1100	900	1200
EE 13-0,50/ 700	0,50	850	700	860
EE 13-0,70/ 325	0,70	390	325	410
EE 13-1,00/ 125	1,00	150	125	180

EE 13

- * Speicherdrossel für Anwendung in Schaltreglern bei Frequenzen von 20 .. 100 kHz bzw. 100 .. 300 kHz
- * Nenninduktivitätsbereich von 125 μH bis 8500 μH
- * Nennstrombereich von 0,12 ADC bis 1,0 ADC
- * Aufbau in stehender Bauform für geringen Grundflächenbedarf von 14,5 x 10 mm
- * Kostengünstige offene Bauform, als Option auch vergossen möglich
- * Geringes Streufeld durch innenliegenden Luftspalt
- * Kompakte und kostengünstige Alternative zu bekannten Ringkernbauformen
- * Sonderausführungen mit 2 Wicklungen für wahlweise Reihen-/Parallelschaltung auf Anfrage
- * Spulenkörpermaterial: PA6, glasfaserverstärkt, UL 94 HB, Isolationsklasse B, (UL 94V-1 auf Anfrage)
- * Bestellhinweis: Typ, Schaltfrequenz, UL 94V-1 wenn benötigt

Speicherdrosseln, stehend

Baureihe EE 16



Ansicht auf Stiftseite
Raster = 3,75 mm



Wicklungsanordnung

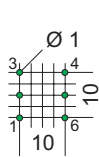
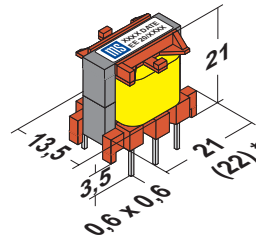
Typ	Vorzugsreihe 1/2L ² ca. 250 μWs			
	Nennstrom [ADC]	Lo [μH]	Ln [μH]	Rcu [mOhm]
EE 16-0,25/ 8500	0,25	12000	8500	7800
EE 16-0,40/ 3600	0,40	5100	3600	3250
EE 16-0,50/ 2250	0,50	3200	2250	2050
EE 16-0,75/ 1000	0,75	1400	1000	890
EE 16-1,00/ 525	1,00	750	525	490
EE 16-1,25/ 280	1,25	400	280	275
EE 16-1,50/ 225	1,50	320	225	200
EE 16-1,75/ 200	1,75	280	200	170
EE 16-2,00/ 175	2,00	250	175	145
EE 16-2,50/ 85	2,50	120	85	78
EE 16-3,00/ 65	3,00	90	65	55

EE 16

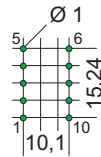
- * Speicherdrossel für Anwendung in Schaltreglern bei Frequenzen von 20 .. 100 kHz bzw. 100 .. 300 kHz
- * Nenninduktivitätsbereich von 65 μH bis 8500 μH
- * Nennstrombereich von 0,25 ADC bis 3,0 ADC
- * Aufbau in stehender Bauform für geringen Grundflächenbedarf von 16 x 11,5 mm
- * Kostengünstige offene Bauform, als Option auch vergossen möglich
- * Geringes Streufeld durch innenliegenden Luftspalt
- * Kompakte und kostengünstige Alternative zu bekannten Ringkernbauformen
- * Sonderausführungen mit 2 Wicklungen für wahlweise Reihen-/Parallelschaltung auf Anfrage
- * Spulenkörpermaterial: PA6, glasfaserverstärkt, UL 94 HB, Isolationsklasse B, (UL 94V-1 auf Anfrage)
- * Bestellhinweis: Typ, Schaltfrequenz, UL 94V-1 wenn benötigt

Speicherdrosseln, stehend

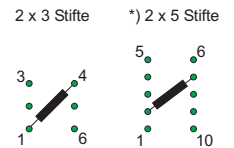
Baureihe EE 20



Ansicht auf Stiftseite
Raster = 2,5 mm



*) Ansicht auf Stiftseite
Raster = 3,81 mm



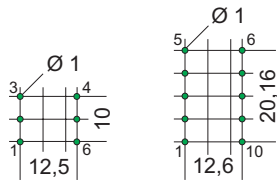
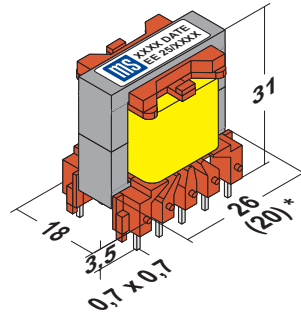
Wicklungsanordnung

EE 20	Vorzugsreihe 1/2L ² ca. 500 μWs				
	Typ	Nennstrom [ADC]	Lo [μH]	Ln [μH]	Rcu [mOhm]
EE 20-0,30/ 10000	0,30	13700	10000	5450	
EE 20-0,40/ 6150	0,40	8800	6150	3500	
EE 20-0,50/ 4900	0,50	7000	4900	2450	
EE 20-0,70/ 2800	0,70	4000	2800	1450	
EE 20-0,85/ 1550	0,85	2250	1550	865	
EE 20-1,00/ 925	1,00	1320	925	520	
EE 20-1,30/ 775	1,30	1100	775	385	
EE 20-1,50/ 630	1,50	900	630	310	
EE 20-1,75/ 365	1,75	515	365	210	
EE 20-1,90/ 325	1,90	460	325	175	
EE 20-2,15/ 280	2,15	400	280	145	
EE 20-2,50/ 140	2,50	200	140	90	
EE 20-3,00/ 125	3,00	175	125	69	
EE 20-3,50/ 110	3,50	150	110	52	
EE 20-4,00/ 92	4,00	130	92	45	

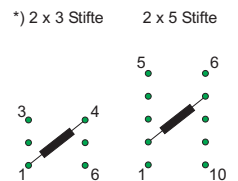
- * Speicherdrossel für Anwendung in Schaltreglern bei Frequenzen von 20 .. 100 kHz bzw. 100 .. 300 kHz
- * Nenninduktivitätsbereich von 92 μH bis 10000 μH
- * Nennstrombereich von 0,3 ADC bis 4,0 ADC
- * Aufbau in stehender Bauform für geringen Grundflächenbedarf von 21 x 13,5 mm
- * Kostengünstige offene Bauform, als Option auch vergossen möglich
- * Geringes Streufeld durch innenliegenden Luftspalt
- * Kompakte und kostengünstige Alternative zu bekannten Ringkernbauformen
- * Sonderausführungen mit 2 Wicklungen für wahlweise Reihen-/Parallelschaltung auf Anfrage
- * Spulenkörpermaterial: PA6, glasfaserverstärkt, UL 94 HB, Isolationsklasse B, (UL 94V-1 auf Anfrage)
- * Bestellhinweis: Typ, Schaltfrequenz, UL 94V-1 wenn benötigt
- * Wahlweise in 2 x 3 Stifte oder 2 x 5 Stifte

Speicherdrosseln, stehend

Baureihe EE 25



*) Ansicht auf Stiftseite Raster = 5 mm Ansicht auf Stiftseite Raster = 5,04 mm



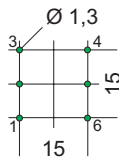
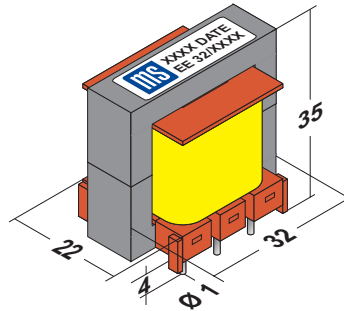
Wicklungsanordnung

EE 25	Vorzugsreihe $1/2LI^2$ ca. 1500 μ Ws				
	Typ	Nennstrom [ADC]	Lo [μ H]	Ln [μ H]	Rcu [mOhm]
	EE 25-0,50/ 10000	0,50	14500	10000	3900
	EE 25-1,00/ 2800	1,00	4000	2800	1150
	EE 25-1,50/ 1350	1,50	1900	1350	510
	EE 25-2,00/ 775	2,00	1100	775	310
	EE 25-2,50/ 600	2,50	840	600	215
	EE 25-3,00/ 300	3,00	420	300	120
	EE 25-4,00/ 230	4,00	325	230	85
	EE 25-5,00/ 110	5,00	150	110	45

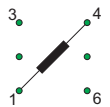
- * Speicherdrossel für Anwendung in Schaltreglern bei Frequenzen von 20 .. 100 kHz bzw. 100 .. 300 kHz
- * Nenninduktivitätsbereich von 110 μ H bis 10000 μ H
- * Nennstrombereich von 0,5 ADC bis 5,0 ADC
- * Aufbau in stehender Bauform für geringen Grundflächenbedarf von 26 x 18 mm
- * Kostengünstige offene Bauform, als Option auch vergossen möglich
- * Geringes Streufeld durch innenliegenden Luftspalt
- * Kompakte und kostengünstige Alternative zu bekannten Ringkernbauformen
- * Sonderausführungen mit 2 Wicklungen für wahlweise Reihen-/Parallelschaltung auf Anfrage
- * Spulenkörpermaterial: PA6, glasfaserverstärkt, UL 94 HB, Isolationsklasse B, (UL 94V-1 auf Anfrage)
- * Bestellhinweis: Typ, Schaltfrequenz, UL 94V-1 wenn benötigt
- * Wahlweise in 2 x 3 Stifte oder 2 x 5 Stifte

Speicherdrosseln, stehend

Baureihe EE 32



Ansicht auf Stiftseite
Raster = 7,5 mm

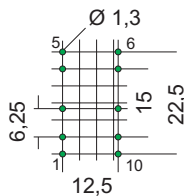
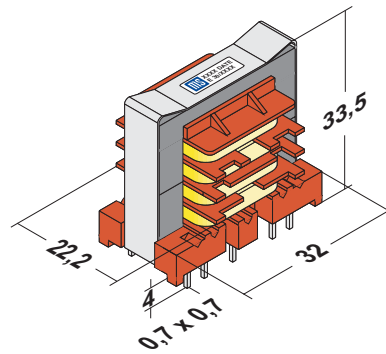


Wicklungsanordnung

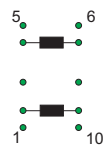
EE 32	Vorzugsreihe $1/2LI^2$ ca. 3500 μ Ws				
	Typ	Nennstrom [ADC]	Lo [μ H]	Ln [μ H]	Rcu [mOhm]
	EE 32-1,00/ 7500	1,00	11000	7500	2100
	EE 32-1,50/ 3000	1,50	4350	3000	850
	EE 32-2,00/ 1750	2,00	2500	1750	510
	EE 32-2,50/ 1400	2,50	1950	1400	320
	EE 32-3,00/ 750	3,00	1050	750	210
	EE 32-4,00/ 390	4,00	550	390	120
	EE 32-5,00/ 300	5,00	425	300	85

- * Speicherdrossel für Anwendung in Schaltreglern bei Frequenzen von 20 .. 100 kHz bzw. 100 .. 300 kHz
- * Nenninduktivitätsbereich von 300 μ H bis 7500 μ H
- * Nennstrombereich von 1,0 ADC bis 5,0 ADC
- * Aufbau in stehender Bauform für geringen Grundflächenbedarf von 32 x 22 mm
- * Kostengünstige offene Bauform, als Option auch vergossen möglich
- * Geringes Streufeld durch innenliegenden Luftspalt
- * Kompakte und kostengünstige Alternative zu bekannten Ringkernbauformen
- * Sonderausführungen mit 2 Wicklungen für wahlweise Reihen-/Parallelschaltung auf Anfrage
- * Spulenkörpermaterial: PA6, glasfaserverstärkt, UL 94 HB, Isolationsklasse B, (UL 94V-1 auf Anfrage)
- * Bestellhinweis: Typ, Schaltfrequenz, UL 94V-1 wenn benötigt

Funktentstördrosseln, stromkompensiert E 30/7-30



Ansicht auf Stiftseite
Raster = 3,75 mm



Wicklungsanordnung

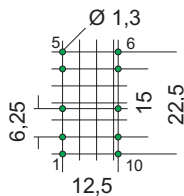
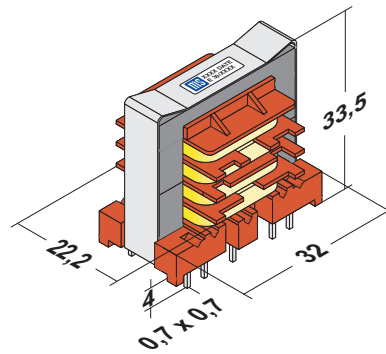
E 30/7-30	Typ	Nennstrom	Induktivität +30%/-20% [mH]	Streuinduktivität typ [µH]	Wicklungswiderstand je Wicklung [mOhm] (typ)
	MS 2610	0,5 A	2 x 150	2000	3200
MS 2611	1,0 A	2 x 60	900	1000	
MS 2612	1,4 A	2 x 30	450	500	
MS 2613	2,0 A	2 x 12	150	200	
MS 2614	3,0 A	2 x 6,5	80	100	
MS 2615	4,0 A	2 x 4,5	50	65	

- * Verwendung von Kernen mit besonders hoher Permeabilität
- * Sonderversionen sowie andere Stiftbelegungen auf Anfrage

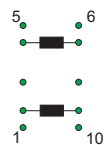
Technische Daten:

Nennspannung:	250 VAC / 50/60 Hz
Nennstrombereich:	0,5 ... 4,0 A
Prüfspannung Wicklung/Wicklung:	1500 VAC / 50 Hz 2 sec
Prüfspannung Wicklung 1+2/Kern:	1500 VAC / 50 Hz 2 sec
Aufbau: Spulenkörper:	4-Kammer Ultramid A3X2G5 UL 94-V0
Imprägnierung:	E 8571 UL-gelistet

Funktentstördrosseln, stromkompensiert E 30/7-35



Ansicht auf Stiftseite
Raster = 3,75 mm



Wicklungsanordnung

E 30/7-30	Typ	Nennstrom	Induktivität +30%/-20% [mH]	Streuinduktivität typ [µH]	Wicklungswiderstand je Wicklung [mOhm] (typ)
	MS 2620	0,5 A	2 x 200	2000	3200
MS 2621	1,0 A	2 x 80	900	1000	
MS 2622	1,4 A	2 x 40	450	500	
MS 2623	2,0 A	2 x 16	150	200	
MS 2624	3,0 A	2 x 9	80	100	
MS 2625	4,0 A	2 x 6,5	50	65	

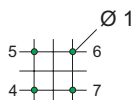
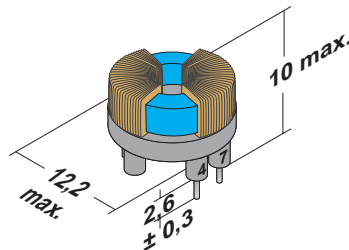
- * Verwendung von Kernen mit besonders hoher Permeabilität
- * Sonderversionen sowie andere Stiftbelegungen auf Anfrage

Technische Daten:

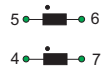
Nennspannung:	250 VAC / 50/60 Hz
Nennstrombereich:	0,5 ... 4,0 A
Prüfspannung Wicklung/Wicklung:	1500 VAC / 50 Hz 2 sec
Prüfspannung Wicklung 1+2/Kern:	1500 VAC / 50 Hz 2 sec
Aufbau: Spulenkörper:	4-Kammer Ultramid A3X2G5 UL 94-V0
Imprägnierung:	E 8571 UL-gelistet

Funkentstördrosseln, stromkompensiert

R 10



Ansicht auf Stiftseite
Raster = 2,54 mm



Wicklungsanordnung

R 10 liegend	Typ	Nennstrom	Induktivität +30%/-30% [mH]	Streuinduktivität typ [µH]	Wicklungswiderstand je Wicklung [mOhm] (typ)	
	MS 4547		0,2 A	2 x 25,6	2000	1000
			0,3 A	2 x 10,2	900	440
			0,4 A	2 x 6,5	43	280
			0,6 A	2 x 3,2		140
			1,0 A	2 x 1,3		60

- * Verwendung von Kernen mit besonders hoher Permeabilität
- * Prüfspannung: 500 V Wicklung - Wicklung
- * Sonderversionen sowie andere Stiftbelegungen auf Anfrage

Technische Daten:

Nennspannung:
Nennstrombereich:
Isolationsklasse:

250 VAC / 50/60 Hz
0,2 ... 1,0 A
ta 70°C/B